

# Silicon Diode

## **BY268**

1400V / 0,8A

# DATASHEET

OEM – Telefunken

Source: Telefunken Databook 1988

## BY 268 · BY 269

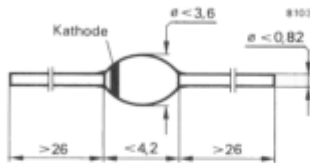
### Silizium-Mesa-Dioden

Anwendungen: Hochspannungsgleichrichter

#### Besondere Merkmale:

- Glaspassivierte Sperrschicht
- Hermetisch dichtes Gehäuse

#### Abmessungen in mm



Sinterglasgehäuse  
SOD 57  
Gewicht max. 0,5 g

#### Bestempfung: Klartext

#### Absolute Grenzwerte

		BY 268	BY 269	
Spitzensperrspannung	$U_{RSM}$	1600	1800	V
Sperrspannung	$U_R$	1400	1600	V
Stoßdurchlaßstrom $t_p = 10 \text{ ms}$	$I_{FSM}$	20		A
Durchlaßstrom, Mittelwert	$I_{FAV}$	0,8		A
Sperrschichttemperatur	$T_j$	175		°C
Lagerungstemperaturbereich	$T_{stg}$	- 65.....+ 175		°C

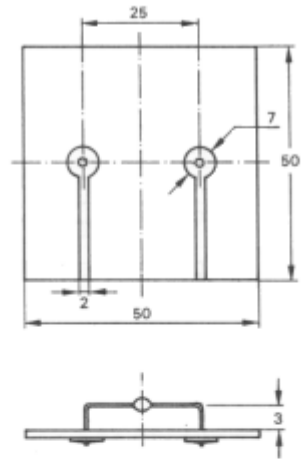
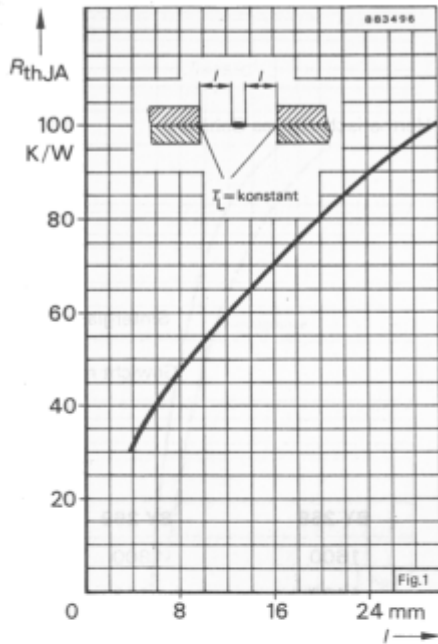
#### Maximaler Wärmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung auf Leiterplatte im Raster 25 mm	$R_{thJA}$	110		K/W
---	------------	-----	--	-----

#### Kenngößen

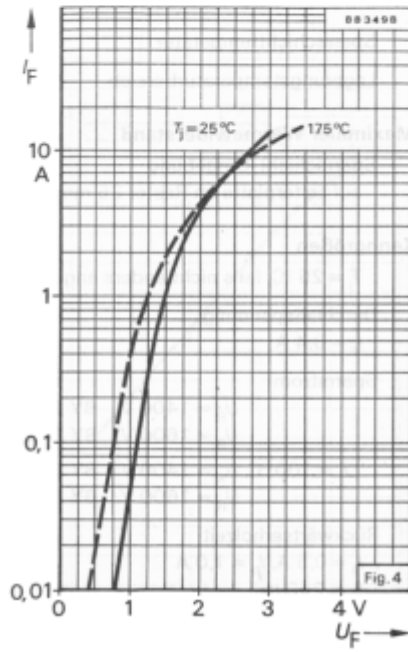
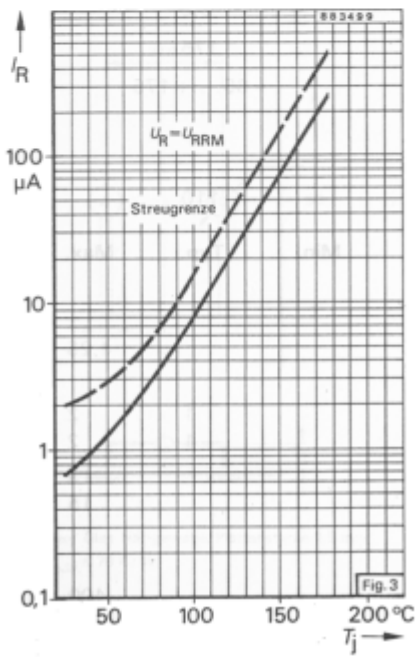
		Min.	Typ.	Max.	
$T_j = 25 \text{ °C}$ , falls nicht anders angegeben					
Durchlaßspannung $I_F = 0,4 \text{ A}$	$U_F$			1,25	V
Sperrstrom	$U_R = 1400 \text{ V}$ BY 268		1	2	$\mu\text{A}$
	$U_R = 1600 \text{ V}$ BY 269		1	2	$\mu\text{A}$
$T_j = 100 \text{ °C}$ , $U_R = 1400 \text{ V}$	BY 268			15	$\mu\text{A}$
	$U_R = 1600 \text{ V}$ BY 269			15	$\mu\text{A}$
Rückwärtserholzeit $I_F = 0,5 \text{ A}$ , $I_R = 1,0 \text{ A}$ $I_R = 250 \text{ mA}$	$t_{rr}$			400	ns

**BY 268 · BY 269**



Epoxy Glas Hartgewebe, Plattenstärke: 1,5 mm  
 $R_{th,JA} \leq 110 \text{ K/W}$

Fig. 2 88 3497



**BY 268 · BY 269**